

拒絶理由通知書

特許出願の番号	平成11年 特許願 第317962号
起案日	平成15年12月25日
特許庁審査官	今井 淳一 9055 4R00
特許出願人代理人	好宮 幹夫 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記1～3の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

【請求項1, 2, 3, 4, 5に対して】

1, 特開平5-114583号公報

(第10～24段落: プラズマ装置においてフォーカスリングとして使用される単結晶シリコンから成るシリコンフォーカスリングに相当する点)

2, 特開平9-283495号公報

(第11～49段落: シリコンフォーカスリングに含有されている格子間酸素濃度が $1 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^3$ 以上であることに相当する点)

3, 特開平11-92283号公報

(第12～76段落: 格子間酸素濃度が $5 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以上 $1.5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下であることに相当する点)

備考

引用例2に記載されているように格子間酸素は通常のシリコン単結晶であれば含まれ、その濃度も引用例2に表記のもの以上に含ませることも周知であったと認められるので、この点に進歩性は認められない。また、引用例2ではシリコン電極に関する記載であるが、引用例1に記載されているようにシリコン単結晶からなるフォーカスリングは周知であるから、引用例1においても通常用いられるシリコン単結晶を用いれば上記の程度の格子間酸素な濃度であると認められる。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第 7 版 H 0 1 L 2 1 / 3 0 6 5

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。